#### ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60-37114

Mint Cl.4

識別記号

庁内整理番号

個公開 昭和60年(1985)2月26日

H 01 G 9/05

B-7435-5E

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

国発明の名称

固体電解コンデンサ

到特 願 昭58-144374

御出 願 昭58(1983)8月9日

720発 明 者 小 林 征 男

東京都世田谷区玉川4-19-14

砂発 明 者 藤

一 美 横浜市戸塚区原宿町1151-2 総一郎

79発明 肝上 川崎市中原区北谷町95-1

昭和電工株式会社 ①出 願

東京都港区芝大門1丁目13番9号

砂代 理 弁理士 菊地 精一

1. 発明の名称

固体電解コンデンサ

2. 特許請求の範囲

一般式

で表わされるくり返し単位を有する高分子化合物 にドーパントをドープして得られる電導性高分子 化合物を、固体電解質とすることを特徴とする因 体電解コンデンサ。

# 3. 発明の詳細な説明

本発用は、一般式(I)式で表わされるくり返 し単位を有する高分子化合物にドーパントをドー プレで限られる智雄性高分子化合物を固体電解質 とする固体電解コンデンサに関する。

固体電解コンデンサは暗幅器化皮膜を有するア ルミニウム、タンタルなどの皮膜形成金属に固体

電解 質を付待した 構造を有している。 従来のこの 種の固体コンデンサの固体電解質には主に硝酸マ ンガンの熱分解により形成される二酸化マンガン が用いられている。しかし、この熱分解の際に要 する高熱と発生するNOェガスの酸化作用などに よって誘電体であるアルミニウム、タンタルなど の金属酸化皮膜の損傷があり、そのため耐電圧は 低下し、もれ電流が大きくなり、誘電特性を劣化 させるなど値めて大きな欠点がある。また、再化 成という工程も必要である。

これらの欠点を捕うため、高熱を付加せずに固 体置解質圏を形成する方法、つまり高電導性の有 機半導体材料を固体電解質とする方法が試みられ ている。その例としては、特周昭52-79255 号公 . 組に記載されている 7,7.8,8-テトラシアノキノ ジメタン(TCNQ) 暗塩を含む電線性高重合体 組成物を固体電解質として含む固体電解コンデン サ、特開昭58- 17609号公組に記載されている N — n — プロピルイソキノリンと 7.7.8.8— テト ラシアノキノジメタンからなる鉛塩を固体電解コ ンデンサが知られている。これらTCNQ銷塩化合物は関極酸化皮膜との付着性に劣り、電導度も10<sup>-3</sup> ~10<sup>-2</sup> S・cu<sup>-1</sup> と不十分であるため、コンデンサの容量値は小さく認電損失も大きい。また熱的経時的な安定性も劣り信頼性が悪い。

本発明の目的は、上述した従来の欠点を解決するため、電導度が高く、誘電体皮蔵との付着性のよい有機半導体を固体電解質に用いた固体電解コンデンサを延供することにある。

本発明は固体電解質に(I)式で表わされるくり返し単位を有する高分子化合物にドーパントをドープして得られる電導性高分子化合物を用い、な発明により得られる固体電解コンデンサは世界の無理酸化半導体や有機半導体を用いた固体電解コンデンサに比して容量、誘電過失、軽詩安定性において著しく優れた性能を有している。

以下本発明について詳細に説明する。

本発明で用いられる高分子化合物は下記の構造を有するものであり

あるいは、BFI 、CLOI 、PFI 、AsFI などのアニオンを電気化学的方法を用いてドープすることによって電気伝導度を $10^{-1}\sim 10^2$  S  $cm^{-1}$  まで高めることができる。

したがって一般式(I) 式で表わされる、くり返し単位を有する高分子化合物、例えばポリチオフェン・ポリピロール・ポリフラン等にドーパントをドープして何られる電源性高分子化合物を覚

歴質に用いれば下記のごとき効果が得られる。

① 高温加熱をすることなしに留解質量を形成できるので層板の酸化皮膜の質優がなく、鉛体のための異複酸化(再化成)を行なう必要がない。そのため定格電圧を従来の数倍にでき、周容量、同定格電圧のコンデンサをを得るのに形状を小型化できる。

- ② もれ電流が小さい。
- ② 高耐圧のコンデンサを作製できる。
- ④ 電解質の程導度が ~102 S・cm と十分に高いため、グラファイトなどの準電図を設ける必要がなく、工程が簡略化される。本発明による図

R R' ただし
C - C R, R' はアルギル基またはH X は O、S または N R " R" はアルギル 基または H

代表例としては、ポリチオフェン、ポリピロール、ポリフランがあげられる。これら高分子化合物の製造方法は特に限定されるものではないが例えばポリチオフェンについては J. Polym. — Soi. Polym. tett. Ed..18. 9(1980);
J. Electroanai, ohem., 135 . 173(1982)
Makromol . ohem., Rapid common. 2,551
(1981), ポリピロールについては J. C. S. ohem. oompun., 854 (1979)及び J. polym.
Sol. polym. Lett. Ed. 20. 107(1982).
ポリフランについては J. Electroanai, chem., 135 . 173(1982) 等の方法によって製造することができる。

また、これら高分子化合物にl2、Br2、 SO2、A3 F5、Sb F5、などの電子受容体 を化学的方法を用いて、ドープすることによって、

体電解コンデンサの級略を第1回に示した。 アルミニウム、タンタル、ニオブ等の弁作用金属を協議を開き形成する。 さらに 銀ペーストで 陰極を取り出し、ケースに入れ樹脂等で密封外装して固体銀卵コンデンサを得る。

以下実施例を示し、本発明を詳和に説明する。 実施例 1

Ta 粉末の焼桔体をリン酸水溶液中で開複酸化して、誘電体皮膜を形成させた後、Ta 索子を、ポリチオフェンークロロホルム溶液に浸液し、乾燥する。この浸液、乾燥の恐作をくり返し、高分子層を形成し、As Fs をドープしたポリチオフェンの電導度は、As Fs をドープしたポリチオフェンの電導度は、As Fs をドープしたポリチオフェンの電導度は、10-1 S・00-1 であった。

### 実施例2

## 特團昭60- 37114(3)

を 0.01 M溶解させた 0.1M Bu 4 NB F 4 - CH 2 CNを使用して電解競合を行ない、Ta 素子上にBF 4 をドープしたポリチオフェンの電解質圏を形成し、固体電解コンデンサを作成した。

BF4 をドープしたポリチオフェンの電導度は 10<sup>2</sup> S・cm<sup>4</sup> であった。

### 夹 饰 例 3

実施例2において、チオフェンモノマーの代り にピロールモノマーを使用して電解質面を形成し 同様に関体電解コンデンサを作成した。

BF4 をドープしたポリピロールの確準度は 10<sup>2</sup> S・cs<sup>-1</sup> であった。

### 実施例4

実施例2において、チオフェンモノマーの代り にフランモノマーを使用して電解質層を形成し、 関様に固体電解コンデンサを作成した。

BF4 をドープしたポリフランの電券度は 10S・cn-1 であった。

実施例1と同様な個極酸化した丁a 素子を用いた従来の二酸化マンガンを電解質とする因体電解

コンデンサの比較例1と実施例1,2,3の特性 を比較したものを第1妻に示す。

		容履(μF)	tan (X)	定格溶圧(V)	もれ電流	遂耐電圧(V)
実施例	1	1.00	0.98	50	10mA以下 a150V	60V 以上
	2	0.99	0.94	50	10nAJXTF at50V	500 以上
	3	0.99	9.95	50	10nALXTF at50V	50V 以上 .
ĺ	4	Ø, 98	1.00	50	10nAIXTF. at50V	40V IX.1:
比較例	-1	1,00	1.02	25	10nA以下 at25V	100 以上

第1表から明らかなように、本発明によるドーパントをドープした電券性高分子化合物を電解質とする固体電解コンデンサに比して誘電銀失もれ電解コンデンサを作成することができる。また発明による関係でフガンを用いた場合とができる。と称電子ンサに比して、大きく、同じ形状ならば大容量を得ることができる。

上記実施例では、素子の金属はタンタル焼結体

であったが、他のアルミニウム、ニオブでもよく、 形状も粉末焼結体に限らない。

### 4. 図面の箇単な説明

第1図は本発明による関体電解コンデンサの一 例を示す所画図である。

1 ··· Ta, A L 等の金属焼結体・

2 … 酸化皮膜

3 … 電導性高分子化合物

4… 遊聞ペースト

5 … 半田

6 … ケースおよび降権

7 --- 風 槙

8 … 封口树脂

特 許 出願人 昭和第三株式会社

代型人 弁理士 菊 地 楷 一

第1図

